**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

1. **Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича**

Проект

* 1. **ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

**“Мікро- та наносистемна техніка”**

**Першого рівня вищої освіти**

**за спеціальністю “Мікро- та наносистемна техніка”**

**галузі знань** G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка/

G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка

**ЗІ ЗМІНАМИ ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ**

**Голова вченої ради
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_ /
(протокол № \_\_\_від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_ **р.)**

 **введено в дію наказом**

 **від " \_\_"\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_ **р за №\_\_\_\_**

**Чернівці 202- р.**

**ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ**

**освітньо-пофесійної програми**

|  |  |
| --- | --- |
| **“ РОЗРОБЛЕНО ”**Робочою групою кафедри електроніки і енергетики ЧНУ імені Юрія ФедьковичаКерівник робочої групи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В. Нічий“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_ р. | **“ УХВАЛЕНО ”**на засіданні кафедри електроніки і енергетикиЧНУ імені Юрія ФедьковичаПротокол №від “ ”\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ р*.*Зав. кафедри\_\_\_\_\_\_Е.В. Майструк |
| **“ СХВАЛЕНО ”**Вченою радою навчально-наукового інституту фізико-технічних і комп’ютерних наук Протокол № \_\_від “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ р.Голова Вченої ради навчально-наукового інституту фізико-технічних і комп’ютерних наук\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шпатар П.М.  | **“ ПОГОДЖЕНО ”**Начальник навчального відділу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Я.Д.Гарабажів“\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ р. |
|  **“ РЕКОМЕНДОВАНО ”**Навчально-методичною комісією Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія ФедьковичаПротокол № \_\_ від “\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ р.Голова комісії університету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Мартинюк О.В.\_\_\_ |

**ПЕРЕДМОВА**

Розроблено робочою групою у складі:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім’я,по батькові керівниката членів проектноїгрупи | Найменуванняпосади, місце роботи | Найменуваннязакладу, який закінчиввикладач,рік закінчення,спеціальність,кваліфікація згідно здокументом про вищуосвіту\* | Науковий ступінь,шифр і найменуваннянауковоїспеціальності, темадисертації, вченезвання, за якоюкафедрою(спеціальністю)присвоєно | Стаж науково-педагогічної та/абонаукової роботи | Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідній роботі, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво науковою роботою студентів) | Відомості пропідвищеннякваліфікації викладача(найменуваннязакладу, виддокумента, тема, дата видачі) |
| Керівник проектноїгрупи |  |  |  |  |  |  |
| Нічий Сергій Васильович | доцент кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича | Чернівецький державний університет у 1990 р., спеціальність “Напівпровідники і діелектрики” | Кандидат фіз.-мат.наук, диплом КН №014973, виданий ВАК України 27.06.1997 р.Тема дисертації:“Отримання плівок і відпал твердих розчинів CdXHg1-XSe з використання лазерного опромінення”, 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків.Старший науковий співробітник зі спеціальності “Фізика напівпровідників і діелектриків”, АС № 002108, 13.02.2002 р.Доцент кафедри фізики напівпровідників і наноструктур,ДЦ № 010485, 17.02.2005 р. | 27 р. | 1.Науковий керівник канд. дисер. Стрєбєжєва В.В. "Оптичні і фотоелектричні елементи інфрачервоного діапазону на основі монокристалів і шарів In4Se3, In4Тe3 та CdSb", захист 27.10.2015 спец. рада к76.051.092. I.Г. Орлецький, М.І. Iлащук, Е.В. Майструк, М.М. Солован, П.Д. Мар’янчук, С.С. Нiчий. Електричнi властивості НДН-гетероструктур n-SnS2/CdTeO3/p-CdZnTe. //УФЖ –2019, т.64. №2. –с. 161-169. 1. 3. E.V. Maistruk, M.I. Ilashchuk, I.G. Orletskyi, I.P. Koziarskyi, P.D. Marianchuk, H.P. Parkhomenko, D.P. Koziarskyi, S.V. Nichyi, Electricand photoelectric properties of vacuum-depositedZnO:Al/CdS/p-Cd1−xZnxTe heterojunctions, Optik. 241 (2021) 167246.
2. 5. Нічий С.В., Нічий Б.С. Історія застосування безпровідних пристроїв у медицині / С.В. Нічий, Б.С. Нічий Актуальні питання суспільних наук та історії медицини: Спільний українсько-румунський науковий журнал, 2020, 2 частина (с. 26).

6. Нічий С.В. Пристрій програмного керування твердотільним імпульсним лазером // Науковий вісник Чернівецького університету 2008. вип. 420. Фізика. Електроніка. С. 58-60.  7. Патент на корисну модель №69106. Спосіб створення омічних контактів до напівпровідникових метеріалів. Грицюк Б.М. Нічий С.В. Громко Є.В. 2012 р. 8. Патент на корисну модель №82724. Спосіб створення бар’єрів Шоткі. Грицюк Б.М. Нічий С.В. Політанський Л.Ф. 2013 р 9. НічийС.В. Спосіб вимірювання питомої провідності однорідних напівпровідникових матеріалів. Патент на корисну модель №32572  | ТДВ "СКБ Електронмаш"М. Чернівці25.10 – 3.122021 р.Довідка №77від 9.12.2021 р.Тема"Проектування та розробка мікропроцесорних систем з елементами аналогових пристроїв для підвищення професійного рівня при викладанні курсів із аналогової і цифрової схемотехніки та мікропроцесорної техніки".Тернопільський національний технічний університеті імені Івана Пулюя з курсу “Новітні технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці” з 05.02.2024р. по 15.03.2024р. Свідоцтво (ПК 05408102/001813-24) (6 кредитів). |
| Члени проектної групи |  |  |  |  |  |  |
| Солован Михайло Миколайович | Старший науковий співробітник, Кафедра квантової електроніки, Університету імені Адама Міцкевича, м. Познань, Польша | ЧНУ, 2011 фізична та біомедична електроніка, магістр електроніки(30.06.2011 р., РН № 41038325) | Доктор фізико-математичних наук, 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків, «Електронні явища в планарних та наноструктурованих поверхнево-бар’єрних структурах на основі кремнію, кремнієвмісних та халькоге-ніднихсполук» (рішення Атестаційної колегії МОН від 09.02.2021 № 157), ДД № 010943доцент кафедри електроніки і енергетики (атестат доцента АД № 005431, 24.09.2020 р.) | 6/4 р. | 1.Мар’янчук П.Д., Солован М.М., Брус В.В., Тонкі плівки нітриду титану та гетеропереходи на їх основі: монографія, Чернівці: Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2019. 152 с.2.Мар’янчук П.Д., Солован М.М. Прилади твердотільної електроніки: навчальний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2019. 220 с.3.Мостовий А. І., Солован М.М. Тонкоплівкова електроніка: метод. реком. до лаб. робіт. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2019. 64 с.4.M.M. Solovan, A.I. Mostovyi, H.P. Parkhomenko, M. Kaikanov, N. Schopp, E.A. Asare, T. Kovaliuk, P. Veřtát, K.S. Ulyanytsky, D.V. Korbutyak, V.V. Brus, A High-Detectivity, Fast-Response, and Radiation-Resistant TiN/CdZnTe Heterojunction Photodiode, Adv. Opt. Mater. 11 (2023). 5.M.M. Solovan, A.I. Mostovyi, D. Aidarkhanov, H.P. Parkhomenko, G. Akhtanova, N. Schopp, E.A. Asare, D. Nauruzbayev, M. Kaikanov, A. Ng, V.V. Brus, Extreme Radiation Resistance of Self-Powered High-Performance Cs0.04Rb0.04(FA0.65MA0.35)0.92Pb(I0.85Br0.14Cl0.01)3 Perovskite Photodiodes, Adv. Opt. Mater. 11 (2023). 6. N. Schopp, E. Abdikamalov, A.I. Mostovyi, H.P. Parkhomenko, M.M. Solovan, E.A. Asare, G.C. Bazan, T.-Q. Nguyen, G.F. Smoot, V.V. Brus, Interstellar photovoltaics, Sci. Rep. 13 (2023). 7. H.P. Parkhomenko, A.I. Mostovyi, G. Akhtanova, M.M. Solovan, M. Kaikanov, N. Schopp, V.V. Brus, Self-healing of Proton-Irradiated Organic Photodiodes and Photovoltaics, Adv. Energy Mater. 13 (2023).  | Туринський політехнічний університет (Турин, Італія) з 01.11.2015 по 30.06.2016 рокуЗахист докторської дисертації в 2021 р. |
| Стребежев Віктор Миколайович | доцент кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича | Чернівецький державний університет у 1975 р., спеціальність “Фізика”КваліфікаціяФізик | Кандидат фіз.-мат.наук, диплом ДК №016278, виданий ВАК України 09.10.2002 р.Тема дисертації:“Фоточутливі елементи і тонкоплівкові інтерференційні фільтри на базіCdSb та In4Se3 ”, 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем.Доцент кафедри фізики напівпровідників і наноструктур,12ДЦ №02961, 10.11.2011 р. | 38р. | 1) [Olena Maslyanchuk](https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Olena.Maslyanchuk-3204444), [**Viktor Strebezhev**](https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Vi%D1%81tor.Strebezhev-4228214), [Petro Fochuk](https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Petro.Fochuk-18941), [Ihor Fodchuk](https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=Ihor_Fodchuk), [Mykola Sorokatyi](https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Mykola.Sorokatyi-4228223), [Aleksey Bolotnikov](https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Aleksey.Bolotnikov-12572), and [R. B. James](https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Ralph.James-5899)  "The effect of laser treatment on the morphology of graphene /CdTe x-rayand γ-ray detectors"// Proc.SPIE.– 2020, 11494.2) **V.M. Strebezhev**, I.M. Yuriychuk, P.M. Fochuk, V.V. Strebezhev, V.G. Pylypko, M.O. Sorokatyi. Ellipsometric studies and scanning electron microscopy of Cd1-xMnxTe films and layer modified by laser irradiation**//** Proc. SPIE. – 2020. – V.11369. – Р. 1Е-1 – 1Е-8. IF =0,45. 3) Патент України №131779. Ростовий контейнер для електрорідинної епітаксії. Ю.Г. Добровольський, **В.М. Стребежев,** В.В. Стрєбєжєв. В65D 81/00, C30B 19/00, Опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.4) A.I. Savchuk, P.M. Fochuk, V.V. Strebezhev, G.I. Kleto, I.М.Yuriychuk, Y.B. Khalavka, Yu.K. Obedzynskyi, V.М. Strebezhev/ The effect of laser treatment on the morphology and structure of CdSb-Cd1-хMnхTe and CdSb-In4(Se3)1-х Тe3х thin film heterojunctions // [Applied Surface Science](http://www.sciencedirect.com/science/journal/01694332). – 2017. – V.418. – P. 536-541. IF=2,9825) A.I. Savchuk, V.V. Strebezhev, G.I. Kleto, Y.B. Khalavka, I. M. Yuriychuk, P.M. Fochuk, **V.M.Strebezhev/**Properties of CdSb thin film sobtained by RF sputtering // Surface and Coatings Technology.– 2016. – V.295. – P. 8-12. IF=2,417 6) Melnychuk T.A, **Strebegev V.N.** Vorobets G.I. Laser synthesis of thin films and layers of In4Se3, In4Te3 and modification of their structure. // Applied Surface Science, V.254 (2007) P.1002-1006.7) E.I. Gatskevich, G.D. Ivlev, A.I. Rarenko, A.I. Savchuk, **V.N. Strebegev**, Z.I. Zakharuk. Modification of Cd1-xMnxTe crystal surface layers by nanopulsed laser irradiation // Applied Surface Science. 2007. – V.254. –N4. – P.993-996.8) Vorobets G.I.,Vorobets O.I., **StrebegevV.N.** TanasyukYu.V. Laser gettering of structural – impurityd efects in the contacts of metal – intrinsic CdT e with a Schottky barrier. // Applied Surface Science, V.254 (2007) P.942-947.9) G.I.Vorobets, O.I.Vorobets, **V.N.Strebegev.** Laser manipulation of clasters, structurald efects and nanoaggregates in barrier structures on silicon and binary semiconductors. // Applied Surface Science, V. 247, P.590-601, (2005).10) **Стребежев В.М.** Субмікронна технологія: Конспект лекцій. Чернівці: Рута.– 2008.– 84с. | 1.Підвищення кваліфікації: Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 2022 IEEE 41th International Conference on Electronics and Nanotechnology IEEE ELNANO 2022, 10.09.2022 – 14.09.2022, Дистанційна – конференція, Сертифікат, 30 годин (1 кредит). 2.Підвищення кваліфікації: Glarivate Analytics Міжнародна публічна компанія, (Лондон), Дистанційна – Науковий вебінар: “Прикладна наукометрія, цитування та їх аналіз”, 10.09.2022 – 24.09.2022, Сертифікат, 4 години (0,13 кредит). 3.Підвищення кваліфікації: Науково-навчальний центр компанії [**«Наукові Публікації»**](https://spubl.com.ua/uk)**,**Україна, Київ, вул. Герцена, 35, оф. 125. Дистанційна – Науковий вебінар:[“Міжнародний досвід у публікаційній сфері. Успішні публікації у Scopus та Web of Science»](https://spubl.com.ua/uk/webinars), 3.04.2023 – 7.04.2023, Сертифікат, 30 годин (1 кредит).  |
| Юрійчук Іван Миколайович | доцент кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича | Чернівецький державний університет у 1984 р., спеціальність “Фізика” | Кандидат фіз.-мат.наук, диплом ФМ №040944, виданий ВАК України 27.03.1991 р.Тема дисертації:“Вібронна взаємодія в CdTe, легованому 3d-елементами”, 01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків.Старший науковий співробітник зі спеціальності “Фізика напівпровідників і діелектриків”, АС № 002249, 13.15.2002 р.Доцент кафедри фізики напівпровідників і наноструктур,12ДЦ № 047185, 25.02.2016 р. | 34 р. | Чупира С.М., Юрійчук І.М. Програмування мовою Libre Basic для технічних спеціальностей: навч.посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. 96 с.1. V.G. Deibuk, I.M. Yuriychuk, I. Lemberski, Fidelity of noisy multiple-control reversible gates // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2020. V. 23, No 4. P. 385-392.2. I.M. Yuriychuk, Z. Hu, V.G. Deibuk Effect of the Noise on Generalized Peres Gate Operation // In Advances in Computer Science for Engineering and Education II, Editors: **Hu**, Z., **Petoukhov**, S., **Dychka**, I., **He**, M., ICCSEEA 2019, Advances in Intelligent Systems and Computing, V. 938. – Springer International Publishing. – 2019. – P. 428-437.3. O.I. Rozhdov, I.M. Yuriychuk, V.G. Deibuk Building a Generalized Peres Gate with Multiple Control Signals // In Advances in Computer Science for Engineering and Education, Editors: **Hu**, Z., **Petoukhov**, S., **Dychka**, I., **He**, M., ICCSEEA 2018, V. 754, Springer International Publishing. – 2019. – P. 155-164.4. I.M. Yuriychuk, P.M. Fochuk, A.E. Bolotnikov, R.B. James, **Ab initio GGA+U investigations of the structural, electronic, and magnetic properties of Cd1-xMnxTe alloy /** Proc. SPIE, Vol. 11114. – 2019. – P. 11114-1, 11114-10. | 1.Тернопільський національний технічний університеті імені Івана Пулюя з курсу “Новітні технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці” з 05.02.2024р. по 15.03.2024р. Свідоцтво (ПК 05408102/001818-24) (6 кредитів).2. Підвищення кваліфікації на тему: “Аналіз даних та статистичне виведення на мові R.”Сертифікат від 19.01.22 р. про успішне закінчення курсу, наданого через платформу “Prometheus”.3. Підвищення кваліфікації в Sigma Software University за програмою “Techers’ smartup: winter productivity”, 23.01.2023 – 27.01.2023, 5 днів; 30 годин (1 кредит).4. Підвищення кваліфікації в SoftServe за програмою “Devops course for teachers”, 29.06.2022 – 12.08.2022, 7 тижнів; 108 годин (3,5 кредита). |
| Варибок РусланаВалеріївна | Студенткаелектроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича |  | Здобувач освіти по ОПП "Мікро- та наносистемна техніка" |  |  |  |

**Профіль освітньої програми зі спеціальності № 176 “Мікро- та наносистемна техніка”**

|  |
| --- |
| **1 – Загальна інформація** |
| **Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу** | Чернівецький національний університет імені Юрія ФедьковичаКафедра електроніки і енергетики |
| **Ступінь, що присвоюється**  | Бакалавр; Bachelor |
| **Галузь знань** |  |
| **Спеціальність** |

|  |
| --- |
|  Мікро- та наносистемна техніка |

 |
| **Офіційна назва освітньої програми** |

|  |
| --- |
| Мікро- та наносистемна техніка  |

 |
| **Освітня кваліфікація**  | Бакалавр з мікро – та наносистемної техніки |
| **Кваліфікація в дипломі** | Ступінь вищої освіти — Бакалавр,Спеціальність — Мікро- та наносистемна техніка |
| **Тип диплому та обсяг освітньої програми** | Диплом бакалавра, одиничний: * на базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3р. 10 місяців;
* на базі ступеня “молодший бакалавр” (освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”) перезараховується 120 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра за спеціальностями галузі знань №17– “Електроніка, автоматизація та електронні комунікації” (вступ на 3 курс скороченої форми навчання).
 |
| **Наявність акредитації** |  |
| **Цикл/рівень** | Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень. |
| **Передумови** | Повна загальна середня освіта. Для скороченої форми – на базі ОКР молодшого спеціаліста, ступеня молодшого бакалавра. |
| **Мова(и) викладання** | Українська |
| **Термін дії освітньої програми** | 5 років |
| **Інтернет-адресапостійного розміщення опису освітньої програми** |  |
| **2 – Мета освітньої програми** |
| Формування високого рівня професійної підготовки фахівців за спеціальністю “Мікро- та наносистемна техніка” у поєднанні з широким світоглядом в соціально-патріотичній, гуманітарній, фундаментальній та природничо-науковій сферах, надання теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок і всієї повноти компетентностей, необхідних для успішної професійної діяльності, для розв’язання спеціалізованих задач, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, дослідження, розроблення новітніх технологій, матеріалів, приладів і складних систем мікро- та наносистемної техніки; проектування, конструювання, виготовлення, монтажу, модернізації, випробовування і експлуатації виробів мікро- та наносистемної техніки, геліоенергетики, фізичного та біомедичного призначенн та широкого їхнього використання в засобах автоматизаціїї та приладобудуванні. Досягнення мети базується на фундаментальності, цілісності, практичної спрямованості наданих знань і компетентностей, на принципах системності, науковості, наступності та індівідуалізації процесу навчання. |
| **3 - Характеристика освітньої програми** |
| **Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (**за наявності**))** | Галузь знань –Спеціальність “Мікро – та наносистемна техніка”Об’єктами вивчення та діяльності фахівців з мікро- та наносистемної техніки є:* фізичні процеси, закономірності та явища, на яких ґрунтується функціонування мікро- та наносистем, фізичні ефекти, які визначають принципи масштабування в мікро- та глибокосубмікронній області та вибір технологічних процесів і операцій щодо формування функціонально-інтегрованих мікро- та наномасштабних елементів, приладів і систем;
* властивості класичних та нових матеріалів мікро- і наноелектроніки, технологічні процеси, ультрапрецизійні високі технології, принципи дії електронних компонентів з високою функціональною та інформаційною щільністю, типових схем функціональних пристроїв і систем;
* матеріали , технології, технологічні маршрути для виготовлення ефективних електронних приладів, мікро- та наносистемної техніки різноманітного, зокрема фізичного, геліоенергетичного та біомедичного призначення, у тому числі багаторівневих електронних структур, мікро- та наноелектромеханічних пристроїв, біомедичнихнаносенсорів і систем візуалізації;
* обчислювальна техніка та спеціалізоване програмне забезпечення для розрахунків параметрів, характеристик та моделювання виробів мікро- та наносистемної техніки
 |
| **Орієнтація освітньої програми** | Освітньо-професійна програма для підготовки бакалаврів з мікро – та наносистемної техніки, орієнтована на сучасні стратегічні спеціалізації і актуальні професії, в яких практично реалізується інтеграція мікро- і нанотехнологій та нанофізики в єдиний комплекс діяльності, спрямованої на створення ультрамініатюрних електронних систем складної ієрархії, їх окремих елементів та масивів елементів, які визначають нову індустріальну революцію у всіх галузях матеріального виробництва – у електроніці, автоматизаціїї, медицині, енергетиці, матеріалознавстві, в біо- та інформаційних технологіях, захисті навколишнього середовища, у національній безпеці |
| **Основний фокус освітньої програми та спеціалізації** | Загальна та спеціальна освіта і професійна підготовка в предметній області фізики і технології процесів створення приладів мікро- та наносистемної техніки, комп’ютерного проектування й моделювання функціональних елементів, пристроїв, систем мікро- та наноелектроніки.Ключові слова: мікро- та наносистеми, наноструктури, субмікронна та нанолітографія, мікро- та наноелектроніка, нанокомпозити, біомедична техніка, біонаносенсори, геліоенергетика, нанофізика, інформаційні системи,спеціалізованепрограмне забезпечення для проектування та моделювання виробівмікро- та наносистемної техніки |
| **Особливості програми** | Комплекс навчальних дисциплін таспеціальні практики з мікро- та наносистемної техніки, спрямовані на забезпечення фахових компетентностей. |
| **4 – Придатність випускників** **до працевлаштування та подальшого навчання** |
| **Придатність до працевлаштування** | Випускники з успіхом можуть обіймати посади фахівців та керівників в галузевих наукових, проектно-конструкторських, проектних установах і організаціях.Перелік можливих професійних назв робіт згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) 1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій 3133 Оператори медичного устаткування 3139 Інші оператори оптичного та електронного устаткування 3114–Технік-конструктор3439 Інші технічні фахівці в галузі управління |
| **Подальше навчання** | Можливість продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації. |
| **5 – Викладання та оцінювання** |
| **Викладання та навчання** | Форми викладання: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, комп'ютерні практикуми, семінари. Студентсько-центроване навчання, самостійне навчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через лабораторну практику тощо. Практична спрямованість навчання полягає у акценті на прикладну частину при викладанні навчальних дисциплін, виконанні курсових робіт із професійно-орієнтованих навчальних дисциплін за спеціальністю, проведенні виробничої та переддипломної практик на базі підприємств і організацій, що працюють в області спеціальності. |
| **Оцінювання** | Оцінювання реалізується при проведенні поточного та підсумкового контролю знань і умінь студентів за модульно-рейтинговою системою. Поточний контроль здійснюється під час виконання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань на лекціях, лабораторних роботах, практичних заняттях, семінарах. Підсумковий контроль здійснюється при проведенні екзаменів, заліків, на захисті курсових робіт та дипломної бакалаврської роботи (випускна атестація). Критерії оцінювання грунтуються на застосуванні міжнародної системи ЄКТС (оцінки A,B,C,D,E,F ), національної системи (оцінки “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”), та системи оцінки, прийнятої ЗВО (1-100 балів).  |
| **6 – Програмні компетентності** |
| **Інтегральна компетентність** | Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, під час професійної діяльності у галузі мікро- та наносистемної техніки, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів автоматизації та електроніки. |
| **Загальні компетентності (ЗК)** | ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземними мовами. ЗК 5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ЗК 6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 8. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК 9. Здатність працювати в команді. ЗК 10. Навички здійснення безпечної діяльності. ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК 12. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.ЗК 13. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК 15. Здатність ухвалювати рішення та діяти, дотримуючись принципу неприпустимості корупції та будь-яких інших проявів недоброчесності.  |
| **Фахові компетентності спеціальності (ФК)** | ФК 1. Здатність використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів для проектування та застосування мікро- та наносистемної техніки. ФК 2. Здатність виконувати аналіз предметної області та нормативної документації, необхідної для проектування та застосування приладів та пристроїв мікро- та наносистемної техніки. ФК 3. Здатність використовувати математичні принципи і методи для проектування та застосування мікро- та наносистемноїтехніки. ФК 4. Здатність застосовувати відповідні наукові та інженерні методи, сучасні інформаційні технології і комп'ютерне програмне забезпечення, комп'ютерні мережі, бази даних та Інтернет-ресурси для розв’язання професійних задач в галузі мікро- та наносистемної техніки. ФК 5. Здатність ідентифікувати, класифікувати, оцінювати і описувати процеси у мікро- та наносистемній техніці за допомогою побудови і аналізу їх фізичних і математичних моделей.ФК 6. Здатність застосовувати творчий та інноваційний потенціал в синтезі інженерних рішень і в розробці конструктивних елементів геліоенергетики, приладів фізичного та біомедичного призначення.ФК 7. Здатність розв’язувати інженерні задачі в галузі мікро- та наносистемної техніки з урахуванням всіх аспектів розробки, проектування, виробництва, експлуатації та модернізації.ФК 8. Здатність визначати та оцінювати характеристики та параметри матеріалів мікро- та наносистемної техніки, аналогових та цифрових електронних пристроїв, мікропроцесорних систем.ФК 9. Здатність застосовувати на практиці галузеві стандарти та стандарти якості щодо мікро- та наносистемної техніки.ФК 10. Здатність розуміти та застосовувати технологічні принципи виробництва, випробування, експлуатації та ремонту мікро- та наносистемної техніки та біомедичного обладнання. ФК 11. Здатність враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні та комерційні міркування, що впливають на ефективність та результати інженерної діяльності в галузі мікро- та наносистемної електронної техніки.ФК 12. Здатність досліджувати та застосовувати фізичні явища в тонкоплівковихі мікро- та нанорозмірних напівпровідникових об'єктах для побудови елементів та систем мікро- та наносистемної техніки. |
| **7 – Програмні результати навчання** |
|  | ПР 1. Застосовувати знання принципів дії пристроїв і систем мікро- та наносистемної техніки при їхньому проектуванні та експлуатації. ПР 2. Застосовувати знання і розуміння математичних методів для розв’язання теоретичних і прикладних задач мікро- та наносистемної техніки. ПР 3. Застосовувати знання і розуміння фізики, відповідні теорії, моделі та методи для розв’язання практичних задач синтезу пристроїв мікро- та наносистемної техніки. ПР 4. Оцінювати характеристики та параметри матеріалів пристроїв мікро- та наносистемної техніки, знати та розуміти основи твердотільної та оптичної електроніки, наноелектроніки, електротехніки, аналогової та цифрової схемотехніки, мікропроцесорної техніки. ПР 5. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для розв’язання задач проектування та налагодження обладнання геліоенергетики, приладів фізичної та біомедичної електроніки. ПР 6. Застосовувати навички планування та проведення експерименту для перевірки гіпотез та дослідження явищ мікро- та наноелектроніки, вміти використовувати стандартне обладнання, складати схеми пристроїв, аналізувати, моделювати та критично оцінювати отримані результати. ПР 7. Досліджувати характеристики і параметри мікро- та наносистемної техніки, приладів фізичної та біомедичної електроніки з урахуванням цілей дослідження, вимог та специфіки вибраних технічних засобів. ПР 8. Будувати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об’єктів, використовувати їх при розробці нової мікро- та наносистемної техніки та виборі оптимальних рішень. ПР 9. Проектувати пристрої мікро- та наносистемної техніки у відоповідності до вимог замовника і наявних ресурсних обмежень. ПР 10. Розробляти технічні засоби діагностування технічного стану мікро- та наносистемної техніки, приладів фізичної та біомедичної електроніки.ПР 11. Організовувати та проводити планові та позапланові технічні обслуговування, налагодження технологічного устаткування у відповідності до поточних вимог виробництва. ПР 12. Аналізувати нормативно-правові засади впровадження мікро- та наносистемної техніки; оцінювати переваги інженерних розробок, їх екологічність та безпечність. ПР 13. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань з дотриманням норм сучасної української ділової та професійної мови. ПР 14. Вміти засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації, знаходити нові нешаблонні рішення і засоби їх здійснення. ПР 15. Застосовувати розуміння теорії стохастичних процесів, методи статистичної обробки та аналізу даних при розв’язанні професійних завдань. ПР 16. Застосовувати результати досліджень фізичних явищ в тонкоплівковихі мікро- та нанорозмірних напівпровідникових об'єктах для побудови елементів та систем мікро- та наносистемної техніки.ПР 17. Знати основи запобігання корупції, суспільної та академічної доброчесності на рівні, необхідному для формування нетерпимості до корупції та проявів недоброчесної поведінки та вміти застосовувати їх у професійній діяльності. |
| **8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми**  |
| **Кадрове забезпечення** | Науково-педагогічні працівники, що задіяні до викладання дисциплін за освітньо- професійною програмою «Мікро- та наносистемна техніка» мають наукові ступені та вчені звання, з досвідом дослідницької роботи за фахом і повністю відповідає вимогам. |
| **Матеріально-технічне забезпечення** | Забезпеченість навчальними і лабораторними приміщеннями, спеціалізованими комп’ютерними класами та комп’ютерними робочими місцями, безлімітним доступом до мережі Інтернет, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Кафедра має й використовує у навчанні за спеціальністю лазерні технологічні комплекси, растрові електронні мікроскопи РЕМ-100У та РЕМН-2, комплекс для магніто-оптичних досліджень, вакуумні установки для епітаксії плівок та шарів, лазерні еліпсометри, автоматизовані комплекси для вимірювань електрофізичних характеристик, установки вирощування кристалів. |
| **Інформаційне та навчально-методичне забезпечення** | Навчальні матеріали на паперових та цифрових носіях, цифрові бази дистанційного навчання з предметів по спеціальності, веб-сторінка кафедри на сайті університету, яка містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність. Використання платформи електронного навчання ЧНУ, методичних розробок науково- педагогічних працівників, а саме: підручників, навчальних посібників з грифом Вченої ради Чернівецького національного університету, конспектів лекцій, вказівок до лабораторних робіт |
| **9 – Академічна мобільність** |
| **Національна кредитна мобільність** | В рамках національних програм та двосторонніх договорів направлення до ЗВО України на практику, стажування та навчання зі спеціальності мікро- та наносистемна техніка студентів та аспірантів кафедри |
| **Міжнародна кредитна мобільність** | В рамках Міжнародної програми ЄС ERASMUS+ направлення на стажування та навчання до навчальних закладів країн-партнерів зі спеціальності мікро- та наносистемна техніка студентів та аспірантів кафедри |
| **Навчання іноземних здобувачів вищої освіти** | Передбачається навчання іноземних здобувачів вищої освіти згідно даної освітньої програми. Забезпечується володіння викладачами англійською мовою на рівні В2, створення комплексів навчальних дисциплін та програм англійською мовою. |

**2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна послідовність**

**2.1 Перелік компонент ОП**

| Код н/д | Освітні компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість кредитів | Формапідсумк. контр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Повна форма | Скорочена форма 3-х річна |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| **ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП** |
| ***Цикл загальної підготовки*** |
| ОК 1.  | Українська мова (за проф. спрямуванням) | 3,0 |  | екзамен |
| ОК 2.  | Актуальні питання історії та культури України | 3,0 |  | екзамен |
| ОК 3. | Іноземна мова (за проф. спрямуванням) | 6,0 |  | екзамен / залік  |
| ОК 4. | Філософія | 4,0 |  | екзамен |
| ***Цикл професійної підготовки*** |
| **ОК 5.**  | Вища математика: |  |  |  |
| **ОК 5.1.** | Аналітична геометрія, вища алгебра, математичний аналіз, дифрівняння | 16,0 |  | екзамен / екзамен |
| **ОК 5.2.** | ~~Основи векторного і тензорного аналізу/~~Сенсорна мікроелектроніка | 3,0 |  | залік |
| ОК 6. | Фізика: |  |  |
| ОК 6.1. | ~~Фізика ч1~~ Механіка та молекулярна фізика | 4,0 |  | екзамен |
| ОК 6.2. | ~~Фізика ч2~~ Електрика і магнетизм | 4,0 |  | екзамен |
| ОК 6.3.  | ~~Фізика:ч3~~ Оптика і фізика атома | 4,0 |  | екзамен |
|  |  |  |  |  |
| ОК 7  | Інформатика: |  |  |  |
| ОК 7.1. | Інформатика (Ч.1) | 5,0 |  | залік |
| ОК 7.2. | ~~Інформатика (Ч.2)/~~ Агоритми та програмування мовою С++. | 6,5 |  | екзамен /залік  |
| **ОК 8.** | ~~Хімія~~/ Фізико-хімічні технологічні процеси в приладобудуванні | 3,0 |  | екзамен |
| ОК 9. | Основи метрології та електричних вимірювань | 5,5 |  | екзамен |
| **ОК 10.** | Імовірнісні основи обробки даних | 6,0 |  | залік |
| ОК 11.  | Інженерна та комп’ютерна графіка | 6,0 |  | екзамен |
| **ОК 12.** | Обчислювальна математика | 4,5 |  | екзамен |
| **ОК 13.** | Теорія електричних кіл | 10,5 |  | залік, екзамен  |
| **ОК13.1** | Курсова робота з теорії електричних кіл | 1 |  | екзамен |
| **ОК 14.** | Фізика твердого тіла та тонких плівок | 4,0 |  | залік |
| **ОК 15.** | Квантова механіка | 3,0 |  | екзамен |
| ОК 16. | Екологія за професійним спрямуванням | 3,0 |  | залік |
| **ОК 17.** | Фізичні основи електроніки та мікроелектроніки | 5,0 |  | екзамен |
| ОК 18. | Технологія матеріалів та компоненти електроніки і мікроелектроніки | 5,0 |  | екзамен |
| **ОК 19.** | Основи твердотільної електроніки | 6,0 |  | залік |
| ОК 20. | Прилади твердотільної електроніки | 6,0 |  | екзамен |
| **ОК 21.** | Аналогова схемотехніка | 5,5 |  | екзамен  |
| **ОК21.1** | *Курсовий проект з аналогової схемотехніки* | 1,5 |  | екзамен |
| ОК 22. | Основи охорони праці | 3,0 |  | екзамен |
| ОК 23. | Цифрова мікросхемотехніка | 5,0/4,0 |  | екзамен |
| **ОК 24.** | ~~Основи наноелектроніки~~/ Субмікронна- та наноелектрніка | 4,0 |  | екзамен |
| **ОК 25.** | Моделювання в автоматиці і мікроелектроніці | 5,0 |  | екзамен |
| **ОК 26.** | Проектування і конструювання інтегральних мікросхем | 5,5 |  | екзамен  |
| **ОК 26,1** | *Курсовий проект з проектування ІМС* | 1,5 |  | екзамен |
| ОК 27. | Економіка та організація виробництва | 3,0 |  | залік |
| ОК 28. | Мікропроцесорні системи та мікроконтролери | 4,0/5,0 |  | екзамен |
| **ОК 29.** | Виробнича практика | 2,0 |  | залік |
| **ОК 30.** | Переддипломна практика | 4,0 |  | екзамен |
| **ОК 31.** | Дипломне проектування | 6,0 |  | екзамен |
| ОК 32. | Теоретична складова Базової загальновійськової підготовки | 3 |  |  |
| ОК 33. | Практична складова Базової загальновійськової підготовки | 7\*\*\* |  |  |
|  | **ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ** | **180** |  |  |
| **ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП** |
| ***Цикл загальної підготовки*** |
| ВБ 1.1 | Фізичне виховання (за видами спорту) | 3,0 |  | залік |
| ВБ1. 2 | Громадське здоров'я та медицина порятунку / Релігієзнавство / Фізичне виховання ІІ | 3,0 |  | залік |
| **ВБ 1.3** | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) / Вибіркова дисципліна із загально університетського списку | 3,0 |  | залік |
| **ВБ1. 4** | Професійна іноземна мова / Демократія: від теорії до практики | 3,0 |  | залік |
| ***Цикл професійної підготовки*** |
| ВБ 2.1 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.2 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.3 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.4 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.5 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.6 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.7 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.8 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.9 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.10 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.11 | Вибіркова дисциплінаФ/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 2.12 | Вибіркова дисципліна Ф/К каталогу  | 4,0 |  | Залік |
| ВБ 4. | Військова підготовка | 29\*\*\* |  |  |
|  | **ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ**  | **60** |  |  |
|  | **ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ** | **240** |  |  |

Примітки. 1.Освітні компоненти, які виділені зірочкою (\*\*\*) позакредитні обов’язкові /вибіркові освітні компоненти

2. ф/К каталог – факультецький (інститутський)/кафедральний каталог вибіркових дисциплін.

**2.2.1. Структурно-логічна схема ОП**

**(повна форма навчання)**

****

**3.Форма атестації здобувачів вищої освіти**

|  |  |
| --- | --- |
| **Форми атестації здобувачів вищої освіти** | Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою спеціальності ХХХ “Мікро- та наносистемна техніка” здійснюється у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи.Атестація випускників завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Бакалавр з Мікро- та наносистемної техніки.Атестація здійснюється відкрито і публічно. |
| **Вимоги до кваліфікаційної роботи** | Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми в сфері мікро- та наносистемної техніки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов і передбачає застосування теорій та методів електроніки. У кваліфікаційній роботі не повинно бути академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації та списування. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена до захисту на офіційному сайті кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства. |

**4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентами освітньої програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ОК 1 | ОК 2 | ОК 3 | ОК 4 | **ОК 5.1** | **ОК 5.2** | ОК 6.1 | ОК 6.2 | ОК 6.3 | ОК 7.1 | ОК 7.2 | **ОК 8** | ОК 9 | **ОК 10** | ОК 11 | **ОК 12** | **ОК 13** | **ОК 13.1** | **ОК 14** | **ОК 15** | ОК 16 | **ОК 17** | ОК 18 | ОК 19 | ОК 20 | **ОК 21** | **ОК 21.1** | ОК 22 | ОК 23 | **ОК 24** | **ОК 25** | **ОК 26** | **ОК 26.1** | ОК 27 | ОК 28 | **ОК 29** | **ОК 30** | **ОК 31** | ОК32 | ОК33 |
| ЗК 1 |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  | • | • | • |  |  | • | • | • |  |  |
| ЗК 2  |  |  | • | • |  |  | • | • | • | • | • |  | • | • |  |  |  |  | • | • |  | • | • | • |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗК 3 | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |
| ЗК 4 |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |
| ЗК 5 |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |
| ЗК 6 |  |  | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • | • | • | • |  |  |
| ЗК 7 |  |  | • | • |  |  | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |
| ЗК 8 | • | • | • | • |  |  |  |  |  | • | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
| ЗК 9 | • | • | • |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
| ЗК 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |
| ЗК 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • | • | • |  |  |  | • |  |  |
| ЗК 12 |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |
| ЗК 13 |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |
| ЗК 14 |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |
| ЗК 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |
| ФК 1 |  |  | • | • |  |  | • | • | • |  |  | • |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  | • | • | • |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФК 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • | • | • | • |  | • | • | • |  |  |
| ФК 3 |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • | • | • |  |  | • | • | • |  |  |
| ФК 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  |
| ФК 5 |  |  |  |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  | • | • | • |  |  |
| ФК 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  |  | • | • |  | • | • | • | • |  |  |
|   | ОК 1 | ОК 2 | ОК 3 | ОК 4 | **ОК 5.1** | **ОК 5.2** | ОК 6.1 | ОК 6.2 | ОК 6.3 | ОК 7.1 | ОК 7.2 | **ОК 8** | ОК 9 | **ОК 10** | ОК 11 | **ОК 12** | **ОК 13** | **ОК 13.1** | **ОК 14** | **ОК 15** | ОК 16 | **ОК 17** | ОК 18 | ОК 19 | ОК 20 | **ОК 21** | **ОК 21.1** | ОК 22 | ОК 23 | **ОК 24** | **ОК 25** | **ОК 26** | **ОК 26.1** | ОК 27 | ОК 28 | **ОК 29** | **ОК 30** | **ОК 31** | ОК32 | ОК33 |
| ФК 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  |
| ФК 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |
| ФК 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |
| ФК10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • | • |  | • | • |  |  |  |
| ФК 11 |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |
| ФК 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  | • | • |  |  |  |  | • |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ОК 1 | ОК 2 | ОК 3 | ОК 4 | **ОК 5.1** | **ОК 5.2** | ОК 6.1 | ОК 6.2 | ОК 6.3 | ОК 7.1 | ОК 7.2 | **ОК 8** | ОК 9 | **ОК 10** | ОК 11 | **ОК 12** | **ОК 13** | **ОК 13.1** | **ОК 14** | **ОК 15** | ОК 16 | **ОК 17** | ОК 18 | ОК 19 | ОК 20 | **ОК 21** | **ОК 21.1** | ОК 22 | ОК 23 | **ОК 24** | **ОК 25** | **ОК 26** | **ОК 26.1** | ОК 27 | ОК 28 | **ОК 29** | **ОК 30** | **ОК 31** | ОК32 | ОК33 |
| ПР 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • |  |  |
| ПР 2  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • | • |  |  | • |  | • | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПР 3 |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |  | • | • |  |  |
| ПР 4 |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  | • | • | • | • | • | • |  | • | • |  |  |  |  | • | • | • | • |  |  |
| ПР 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  | • |  | • | • |  |  |
| ПР 6 |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |  | • | • |  |  | • | • |  |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |
| ПР 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |
| ПР 8 |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  |  | • | • |  |  |
| ПР 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  | • |  | • | • | • |  | • | • |  |  |  |  |
| ПР 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |  |  |
| ПР 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • | • | • |  | • |  | • | • | • |  |  | • | • | • |  |  |
| ПР 12 |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • |  |  | • | • |  |  |
| ПР 13 | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  | • |  |  |
| ПР 14 |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • | • | • |  |  | • |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • |  | • |  |  | • |  |  |
| ПР 15 |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |
| ПР 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • | • | • |  | • |  | • | • |  |  |  |  | • |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |
| ПР 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  | • |  |  |